

2SD425, 2SD426

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

○電力増幅用

○ Power Amplifier Applications

- コレクタ損失が大きい. : $P_C=100W$ (2SD425, 2SD426)
- 高耐圧です. $V_{CE0}=140V$ (2SD425)
 $V_{CE0}=120V$ (2SD426)
- 2SB555, 2SB556 とコンプリメンタリになります.
- 大電力Hi-Fiオーディオアンプ出力段に最適です.
: $P_O=80W$ (2SD425)
: $P_O=60W$ (2SD426)
- Complementary to 2SB555, and 2SB556
- Recommended for High-Power High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SD425	140	V
	2SD426	120	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SD425	140	V
	2SD426	120	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	12	A
エミッタ電流	I_E	-12	A
コレクタ損失($T_c=25^\circ C$)	P_C	100	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

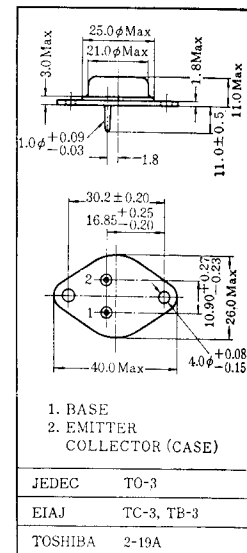
Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60V, I_E=0$	—	—	100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SD425 2SD426	$V_{(BR)CE0}$ $I_C=0.1A, I_B=0$	140	—	—	V
			120	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	40	—	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	2SD425 2SD426	$V_{CE(sat)}$ $I_C=7A, I_B=0.7A$ $I_C=6A, I_B=0.6A$	—	—	3.0	V
			—	—	2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=7A$	—	—	2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_E=-2A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CE}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	330	—	pF

Note: h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SD425 and 2SD426 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SD425—R	40	80
2SD426—R		
2SD425—O	70	140
2SD426—O		

Unit in mm



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT NO. AC73